⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公告

## 特 許 载 (B2) 公 昭56-- 36706

🗐 Int.Cl 🤌

識別記号

庁内整理番号

2000公告 昭和56年(1981) 8月26日

C 23 F 1/02//G 11 C 11/00 H 01 L 21/70 6793-4K 6913 - 5B6426 -- 5F

発明の数 1

(全5頁)

砂港板上に金属パターンを形成する方法

6)特

顧 昭49--133737

(2) LL

17

頤 昭49(1974)11月22日

公

開 昭50 95147

@昭50(1975)7月29日

優先権主張 : 1973年12月20日 1974国(US) @D426862

砂発 明 者 ルボマイアー・タラス・ロマンキ

アメリカ合衆国ニユーヨーク州ブ ライアークリフ・マナー・ダン・ レイン7番地

何出 艇 人 インターナショナル・ビジネス・ マシーンズ・コーポレーション アメリカ合衆国 10504 ニユーヨー ク州アーモンク( 番地なし )

60復代理入 弁理士 岡田次生

## 65特許請求の範囲

1 不活性基板上に第1の薄い金属層を付着し、 該第1金属層上に付着された場合食刻中に上記第 1金属層に対して陽極性となる第2金属層の付着 バターンの縁部を限定するように上記第1金属層 枠を形成し、上記第1金属層上に上記第2金属層 を付着し、上記付第パターンを画成する上記第2 金属層上のみにフォトレジスト層を付着し、上記 フオトレジスト層及び枠によつて囲まれていない 上記第2金属層を除去することを含む基板上に金 30 層を接着層に付着する必要がある。 無バターンを形成する方法。

## 発明の詳細な説明

パーマロイ ( N i -- Fe ) 若しくは他の類似し た合金の電気的メッキの場合、合金の成分はメツ れる。広い領域がマスクされ、そして小さな異な る大きさの即ち一様な大きさでない領域がメッキ

される場合一定の膜の厚さ、一定な合金の成分及 び一様な磁気的性質を用いて、この様な領域を選 択的に付瘡する事が実際には不可能である事は周 知である。この事は100mAのメツキ電流を用 5 いて電気メツキされる領域を100㎡であると仮 定した場合容易に認められよう。電流密度 ja = 100mA PBち1mA/cがである。しかし、100 cnlの表面の領域 ri、 ro及び ry がメツキ処理の

10 間にマスク・アウト (masked out) された場合、 このような領域 r1、 r2及び r3 に対する電流密  $\frac{100 - (r_1 + r_2 + r_3)}{100}$  (1)

1 m A / cdである。

15 パーマロイの様な若しくは同類の合金による記 憶装置、磁気感知装置等を形成する場合、合金内 に所望の割合で成分を含ませることができないと 磁気的特性が低下する。構成成分が一様な性能を 達成する為に正確に制御されなければならない材 20 料を電気メツキする技術に於て、通常のマスク技 法は役に立たない。成分が局部的な電流密度によ り決定される合金のメンキ処理の際に先行技術に 於て成された事はシート状に合金をメツキし、そ して所望されたパターンピシートを食刻する事で 上に所定の高さでフオトレジストの自己保持型の 25 あつた。しかし、電気的メツキによる膜の付着の 場合、合金パターンを支持する基板と台金との間 に接着層を用いる事が必量である。ある種の接着 層に関しては、電気メンキが不可能であるので、 Au、Pt、Pd、Cu、Ni の如き貴金属の海い

しかしながら、磁気合金及び基板と適合する多 くの接着層とメツキ・ベース層は、食刻の間に磁 気合金に対して陰極性になり、ひどいアンダーカ ツトが生じる。例えば、銅若しくはパーマロイが キ・システムの局部的な電流密度によつて決定さ 35 これらと基板との間にクロム若しくはチタンの薄 い腐をはさむことによりガラス若しくはシリコン 基板と接着される。この様な複数個の層が食刻さ

(2)

်ဝ

特公 昭56-36706

れる場合、食刻された金属内で、ひといアンダー カツトが成される。この様なアンダーカツトは、 食刻の際になされた3つの別々の効果によるもの で再現不可能及び制御不可能である。アンダーカ づいている。原則として腐食は等方性であり、食 刻される金属の厚さに対して垂直方向及び厚さに 対して平行方向の両方向とも等しい割合で行なわ れる。この結果、一様な金属のアンダーカツトが 成される。

.3

しかし、膜厚及び必要とされたパターンの大き さが極めて小さくなるに応じて金属の結晶性及び 結晶粒は無視できない。結晶粒界及び結晶粒が異 なる割合で食刻され、不完全な端部を形成する。 ターンの面積に匹敵する様になるに応じて、不整 合はたえず増大する。最終的に食刻の終了の際に 接着層及び若しくはメツキ・ベース金属層が食刻 溶液によるメンキ金属の除去の為に露出された場 合、銅、ニツケル、鉄、ニツケル…鉄、クロム、 20 チタン若しくは金の如き異なる金属が共に存在す る結果として、電池(ガルバノセル)が異なる金 属の間に生じ、その結果陽極金属の極めて早い食 刻が生じる。チタン及びクロムの場合、これらの ーマロイ及び鉄属の金属に対し陰極性になる。プ ラチナ、パラジウム、金岩しくは銅の如き金属が 鉄属の金属と共に挾まれて共存する場合、これら の金属が鉄属の金属に対して陰極として作用する 制御が不可能となる。

この様なアンダーカツトが極めて薄く厳密に間 隔を置かれた平行な導電体若しくは一定な特性を 有さなければならない金属性素子アレイのパツチ 製造を妨げることは明らかである。

アンダーカツトを生じる事なく多層の電気メツ キされた付着物の一様な食刻を達成する為に、本 発明は、所望の陽極性会属を電気メツキする前に 陰極性接着性金属の表面にフォト・レジストの極 くは、フレームとして働く様にそれ自身閉じてい る。第2のフォト・レンスト層が陽極性物質を覆 う場所のみ存在し、かつフォト・レジストわくの 外側部を越えて突出する様に付着され露光されそ

して現像される。実際に於て、陽極性金属即ちパ ーマロイがフォトレジストに完全に囲まれ、その 結果最終的なパターンには必要のない陽極性金属 の食刻は損傷のない所望パターン部分を残し、又 ツトは、化学的食刻が加速性腐食である事実に基 5 2 つ以上の異なる金属が通常の食刻剤を受けた場 合に生じるアンダーカツトを除去する。薄膜記録 ヘンド、パブル・メモリ装置、ジョセフソン ( Josephson )接合等のバッチ製造の如き多くの 技術に於て、金属条線の表面の幅がこの金属条線 10 の底部の幅に等しくなければならない。許容誤差 があまりにも小さいので薄膜の表面と底面の間の サイズの僅かな変化分でさえも完成した装置の動 作に大きく影響する。この様な金属条線を製造す る際に、化学的食刻剤が写真石版方法とともに用 食刻される金属の結晶粒の大きさが食刻されるパー15 いられなければならず、又2つ以上の異なる金属 が接触している領域に於て、食刻剤は意味深いア ンダーカツトを生じる。この様なアンダーカツト を回避する方法を第1図-第4図の説明により逐 次説明する。

第1図(若しくは第5図)に於て、所望された 回路が二酸化シリコン、ガラス若しくは他の同様 な自己保持型絶縁物質の基板2上に作られる。基 板2の表面は、接着性金属4、例えばクロム、チ タン、タンタル、タングステン、ニオフ若しくは 金属の夫々が極めて早く安定化し、ニツケル、パ 25 アルミニウムの如き金属を付着される。このよう な接着性金属4は、陽極性金属として以下参照さ れ主金属を基板に接着させるために最初に用いら れる。一般にこの様な接着性金属層上に容易に能 気メツキ若しくは無電気メツキができないので、 事が明らかであり、Ni、パーマロイ等の食刻を 30 次いでこの接着性層 4 をAu、Pt 、Pd 、Cu 、 Ni、Ni~Fe の様な容易にメツキ可能な金属若 しくは金属合金により金属化する事が望ましい。 基板2を加熱できるような場合には、接着層及び メンキ・ベース層の両方として働く例えばNi、 35 パーマロイ、コパルトの様な物質の単一金属若し くは合金を用いる事が可能である。この様な接着 性屬 4と陰極性層 6はスパツタリング、蒸着技術 若しくは他の任意の方法により付着され得る。

厚さしのフォトレジスト層8は通常の光写真技 めて狭いわくを設置する。この場合上記の狭いわ 40 法により付着される。都合の良いフオト・レジス トは A2 1350 H若しくは A2 1350 Jとし てShipiev社から入手できる。陰極性層 6 からフ オト・レジストをはがす時に装置に損傷を与えな いようなフォト・レジストを選択することが必要 (3)

特公 昭56 36706

10

5

6

である。フォト・レジスト層がマスク(図示せず) を通して紫外線の放射によって露光され、露光さ れない部分が適当なフォト・レジスト食刻剤によ り洗浄された後に残つた条線8は00025~ 0.0 0 5ミリメートル( 0.1~ 0.2ミル)の幅に - 5- のわく 8及び12が所望のバターンを覆う。この なる。この様なフォト・レジスト屬8の狭いわく が最終的バターン(第5図参照)の輪郭を描く。 このわくの幅は食刻されるべき最後の場所の領域 よりも10%小さいものを示し、そして食刻場所 の最終的な横方向寸法の1~2%小さい寸法に押 10 層10がFeCl, により食刻された後、陰極性層 えることが望ましい。実際には、この条線の寸法 は 2.5~1 0 μπの間で、好ましくは~ 2.5 μ m ~ 5.0 μm である。電子感知レジストと電子ビー ムがバターンを形成する為に用いられるならば、 この様な幅は10から05μmになり得る。実際 15 及び接着性層4の残留している狭い線条部は通常 にはこのわくの幅がレジストの高さより大きいか。 若しくは等しい関係を保つ事が望ましい。従つて 電子ビーム・レジストが用いられ、 0.5 ヵ幅のフ レームが形成される場合、付着される金属の高さ は二0.5 μから0.8 μに保たれなければならない。20 するため短期間の通常のスパック食刻をされても

フォト・レジスト層8のわくが準備された後、 パーマロイ合金の様な、磁気記憶へツドの製造に 度々用いられる陽極性材料層 10 が必要な厚さで 付着される。陽極性層10は電気メツキされこの て約0.005から0.008㎜の間の周部的分布厚 にのみ影響する。条線の編が0.005㎜よりも小 さい場合、同様に陽極性層10の成分及び磁気的 性質に影響する。フォト・レジストがたつた シスト層8の端部付近でのメツキ陽極性層10の 厚さの変化は5%以下に測定され、パーマロイ (Ni-Fc)の鉄の変化分はメツキされている パーマロイの鉄成分の含有量の10%より少なく 実際、この様な狭いフォト・レジスト8のわくに よりパーマロイの厚さ及び局部的な電流密度によ る変化はかなり無視できる。

陽極性のバーマロイ層10のメツキが完了した な写真石版技法により陽極性層10の表面に被機 を施される。この層12の露光の為に用いられる マスクは注意深く整列される必要はなく、フオト・ レジストのわく8の外側部14及び16を越えて

2.5/1000㎝位迄ははみ出してもよい。 フォ ト・レジスト 8 のわくの外側に存在する余分な陽 極性層 1 0が食刻される場合(Fe - Ni の為の 適当な食刻はFeCl3である)フオト・レジスト 様なフォト・レジストのわく8及び12は、例え ばクロム、タンタル、金等の陰極性金属の存在の もとでも、わくにより囲まれた部分の陽極性会属 が食刻されることを防止する。この余分な陽極性 6及び接着性層 4は適当な化学的食刻剤により食 刻される。続いて、フオト・レジスト層 8 及び 12が例えばアセトンを用いる事で除去される。 化学的食刻による任意の残留物並びに陰極性隔 6 の短いスパンク食刻により除去される。

この代わりに、バーマロイの食刻の終了後、 Shipleyレジストがアセトンにより除去され、そ してこの試料は陰極性層6及び接着性層4を除去 よい。第4回及び5回が金属を除去して所望のバ ターンを有する最終的な構造を示す。

磁気合金の電気メツキする為の電流密度がメツ キされた層の至る所で一定でなければならない場 様なメツキはフオト・レジスト8の端部から離れ 25 合に特に有効ではある本発明の技法は、陽極性層 10が銅の如き単一金属の場合も同様に適用でき る。本発明の技法は陽極性の単一金属層 1 0 が蒸 ・密技法により付着される場合に於ても適用する事 が確認された。その様な場合に於てフオト・レジ 0.00 5 mm (0.2ミル)の幅なので、フォト・レ 30 スト 8 のわくは陽極金属と陰極金属の間の原望さ れないアンダーカットを防止する為に陽極層 10 の厚さの1.2から2倍の間にすべきである。

説明された本発明の技法は2つの重ね合わされ た層が用いられ、下層が上層の導電層の為の接着 測定された。すなわち20%Fe ±1%である。 35 層であり、若しくは下層がこの上層を用いる装置 の本質的部分を成し、そしてこの様な 2層が異な る金属から成る場合に特に価値がある。本発明は 又、成分が同部的な電流密度に依存する合金が上 記の下層と呼ばれる層を覆つて付着される場合に 後、もう1つのフォト・レジスト層12が一般的 40 特に価値がある。所望されない合金部分の食刻が 生じる際に、上述の合金によりメツキされるべき 所望のバターンの端部を凹むわくを用いそして所 髭のパターンの表面を保護することにより、次の 如き3つの高度に所望された特長が達成される。

つた。

11

(4)

特公 昭56-36706

12

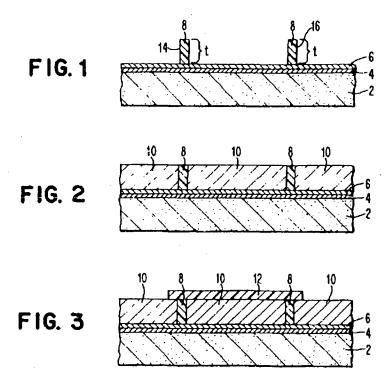
すなわち(1)非常に異なる金属間のアンダーカツト の回避、(2)メツキされるパターンの面積が異なる にもかかわらず合金を一様な厚さで且つ一様な組 成でメツキできること、(3)フォト・レジスト層8 の光学的露光バターンと同様な極めて良好なバタ 5 を行なうための化学的食刻剤を用いてアンダーカ ーンの限定。Shipley 1 3 5 0 H若しくは 1350Jレジストを食刻工程の前に150℃若 しくは160℃まで急速に(~1分から2分の間) 熱する事により更に秀れたハーメチツク・シーリ ングを得ることができる。その様な熱処理は食刻 10 2……基板、4……接着層、6……陰極層、8, の間に生じたレジスト領域8及び12内のどのよ うなわれ目若しくは開孔をも密封することがわか

8

## 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例の最初の状態を示し、 第2、第3及び第4図が複合層内のすべての食刻 フトの欠点が取り除かれる複合層金属の鮮明な条 線を得る方法の結果として起こる段階を示し、第 5図は本発明の技法に従つて造られた完成した基 板の透視図である。

12……フォト・レジスト層(わく)、10…… 陽極層。



13

(5)

特公 昭56-36706

